## Declaration and Power of Attorney For Patent Application 特許出願宣言書及び委任状

## Japanese Language Declaration 日本語宜言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者であると(下記の名称が複数の場合)信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
·	LIGHT EMITTING DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF
上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付)は、	The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:
□月日に提出され、米国出願番号または特許協定条約国際出願番号を とし、(該当する場合)に訂正されました。	was filed onas United States Application Number or PCT International Application Numberand was amended on(if applicable).
私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

## Japanese Languag Declaration (日本語宜言書)

私は、米国法典第35編119条(a)・(d)項又は365条(b)項に基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定している特許協力条約365(a)項に基く国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

(Status: Patented, Pending, Abandoned)

(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)

Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願			Priority Not Claimed 優先権主張なし
2000-115699	Japan	April 17, 2000	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	0
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
私は、第35編米国法典119条(e) 許出願規定に記載された権利をここ		I hereby claim the benefit under Code, Section 119(e) of any lapplication(s) listed below.	
(Application No.)	(Filing Date)	(Application No.)	(Filing Date)
(出願番号)	(出願日)	(出願番号)	(出願日)
私は、下記の米国法典第35編12 特許出願に記載された権利、又は 協力条約365条(c)に基く権利をこ 出願の各請求範囲の内容が米国法 又は特許協力条約で規定された方法 願に開示されていない限り、その先 で本出願書の日本国内または特許に の期間中に入手された、連邦規制法 定義された特許資格の有無に関する 示義務があることを認識しています。	米国を指定している特許 こに主張します。また、本 典代 35 編 112 条第 1 項 去で先行する米国特許出 行米国出願提出日以降 協力条約国際提出日まで :典第 37 編 1 条 56 項で	I hereby claim the benefit under Code, Section 120 of any United 365(c) of any PCT International the United States, listed below a matter of each of the claims of disclosed in the prior United Stapplication in the manner provide of Title 35, United States acknowledge the duty to disclarate in the prior United States acknowledge the duty to disclarate in the prior United States acknowledge the duty to disclarate in the prior United States acknowledge the duty to disclarate in the patentability as defined and the national or PCT Intapplication.	d States application(s), or all application designating and, insofar as the subject of this application is not attes or PCT International ded by the first paragraph Code Section 112, I ose information which is ined in Title 37, Code of a 1.56 which became the of the prior application

(Filing Date)

(出願日)

(Application No.)

(出願番号)

(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基く表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第1001 条に基き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のことく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.



## Japanese Language Declaration (日本語宜言書)

委任状: 私は下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米特許商標局に対して遂行する弁護士または代理人として、下記の者を指名いたします。 (弁護士、または代理人の氏名及び登録番号を明記のこと)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

Daniel W. Sixbey (No. 20, 932) Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26, 477) David S. Safran (Reg. No. 27, 997) Donald R. Studebaker (Reg. No. 32, 815) Tim L. Brackett (Reg. No. 36, 092) Robert M. Schulman (Reg. No. 31, 196) Stuart J. Friedman (Reg. No. 24, 312) Gerald J. Ferguson, Jr. (Reg. No. 23, 016) Thomas W. Cole (Reg. No. 28, 290) Jeffrey L. Costellia (Reg. No. 35, 483) Eric J. Robinson (Reg. No. 38, 285) Thomas M. Blasey (Reg. No. 33, 475) Daniel S. Song (Reg. No. 43, 143)

名した者からその旨通知を受ける。

The undersigned hereby authorizes any U. S. attorney or agent named herein to accept and follow instructions from \_\_\_\_\_\_ as to any action to be taken in the Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U. S. attorney or agent and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U. S. attorneys or agents named herein will be so notified by the undersigned.

書類送付先			Sand C	orresponde	nea to:
實規区刊力	<u> </u>		Sena C	onesponde	nce lo.

Nixon Peabody LLP. 8180 Greensboro Drive Suite 800 McLean, VA 22102

直接電話連絡先: (名前及び電話番号) Direct Telephone Calls to: (name and telephone number) Mr. Eric J. Robinson (703) 790-9110

唯一または第一発明者名	3	Full name of sole or first inventor Shunpei YAMAZAKI
発明者の署名	日付	Inventor's signature Date  Show June 04/04/204
住所		Residence
,		Tokyo, Japan
国籍		Citizenship
		Japanese
私書箱		Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
		398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan



第二共同発明者名	Full name of second joint inventor, if any Takeshi FUKUNAGA
第二共同発明者の署名 日付	Second inventor's signature Date  Jakeshi Frukunaga 04/04/2001
住所	Residence Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第三共同発明者名	Full name of third joint inventor, if any Jun KOYAMA
第三共同発明者の署名 日付	Third inventor's signature Date
住所	Residence
	Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanésē
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第四共同発明者名		Full name of fourth joint inventor, if any
		Kazutaka INUKAI
第四共同発明者の署名	日付	Fourth inventor's signature Date  Kazutaka Inukai 04/05/200/
住所		Residence
		Kanagawa, Japan
国籍		Citizenship
		Japanese
私書箱 Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., L		Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
		398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan